

# 日程表 (会場別) 1

東海大学

会場名	収容人数	3月17日 (水)		3月18日 (木)		3月19日 (金)		3月20日 (土)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
16号館	A 1F-16-101	165	13.6 Si デバイス/集積化技術	「省エネルギー化社会とフォトニックICT」	5.2 光記録	「レーザーディスプレイとその最新光制御技術」	5.3 光制御	5.3 光制御		
	B 1F-16-102	121		13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	5.4 光ファイバー		
	C 2F-16-203	121	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」		13.7 シミュレーション	13.1 基礎物性・評価	13.1 基礎物性・評価	13.1 基礎物性・評価	13.2 半導体表面	13.2 半導体表面
	D 2F-16-204	121	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.4 配線技術	「分科内総合講演: 13 半導体 A (シリコン) 分科内総合講演」	13.4 配線技術	
	E 2F-16-205	121	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	5.1 半導体レーザー・発光/受光素子	
	F 2F-16-206	121	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー
	G 2F-16-207	121		1.2 放射線発生装置・理工学応用 1.3 放射線応用・新技術	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	放射線分科会企画「X線イメージングの最前線」	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	
	J 3F-16-304	121	3.5 情報光学	3.5 情報光学	3.5 情報光学	新画像システム研究会企画「アンコンシャス画像技術とその応用」	3.4 計測光学	「光波センシングを切り拓くイメージング技術の進展」	3.4 計測光学	
	K 3F-16-305	121	3.8 光学新領域	3.2 材料光学	3.1 物理学・光学基礎	3.4 計測光学	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学	3.6 生体・医用光学
	L 3F-16-306	121	4.6 レーザー分光応用・計測	4.6 レーザー分光応用・計測	4.1 量子光学・原子光学	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学
M 5F-16-503	278	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	応用物理学会 THz 電磁波技術研究会企画「テラヘルツ光科学の新展開」	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	
N 5F-16-504	278	5.3 光制御	「表面プラズモン放射フォトニクス II」	5.3 光制御	「ナノフォトニクスを支えるナノ加工」		エネルギー環境研究会企画「人工光合成を中心とした自然エネルギー利用の実現へ向けて」			
6号館	R 1F-6A-101	105	18.1 応用物理一般	18.1 応用物理一般	18.1 応用物理一般	応用物理教育分科会企画「物理のおもしろさを生徒や学生にいかにつなげるか? ~中学、高校、大学における電気・磁気」の授業を中心にして~	8.5 プラズマナノテクノロジー (ショート口頭講演)	「光科学技術における人材育成」		
	S 1F-6A-102	105	18.6 資源・環境	18.5 エネルギー変換・貯蔵	18.3 新技術 18.4 トライボロジー	重力応用研究グループ企画「重力場応用研究」	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 (ショート口頭講演)	衝撃応用研究グループ企画「衝撃現象とその応用物理」		
	T 1F-6A-105	114		18.7 磁場応用	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
	V 1F-6A-106	114			11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	11.4 アナログ応用および関連技術	11.4 アナログ応用および関連技術		
	W 1F-6A-107	114	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	7.1 X線技術	「レーザー駆動単色電子ビーム発生物理とその応用のフロンティア」	7.1 X線技術	7.5 ビーム・光励起表面反応 7.8 ビーム応用一般・新技術		
	ZA 1F-6A-108	114	7.7 微小電子源	7.7 微小電子源	12.4 光機能材料・デバイス		10.3 磁気記録媒体・磁気センサー (ショート口頭講演) 10.4 光・量子スピントロニクス	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般
	ZB 1F-6A-109	114	2.2 精密計測・ナノ計測	2.3 計測標準	8.1 プラズマ生成・制御	8.1 プラズマ生成・制御	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	
	ZC 1F-6A-110	114	8.2 プラズマ診断・計測	8.2 プラズマ診断・計測		9.1 誘電材料・誘電体	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.5 新機能材料・新物性	9.2 微粒子・粉体
	ZD 1F-6A-111	114	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	8.4 プラズマエッチング	8.4 プラズマエッチング	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ		
	ZE 1F-6A-112	114	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術		
	ZF 1F-6A-113	114	12.10 特定テーマ: ナノバイオテクノロジー	12.10 特定テーマ: ナノバイオテクノロジー	12.10 特定テーマ: ナノバイオテクノロジー	12.2 評価・基礎物性	12.10 特定テーマ: ナノバイオテクノロジー	12.2 評価・基礎物性		
	ZG 1F-6B-106	190	12.6 高分子・ソフトマテリアル (ショート口頭講演)	プラズマエレクトロニクス分科会企画「プラズマとナノ界面の相互作用~プロセス揺らぎの制御を目指して~」	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	ナノバイオエンジニアリングの現状と未来像	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野 (ショート口頭講演)	「8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演」		
	ZH 1F-6B-105	190	10.1 新物質創生・物性探索	10.1 新物質創生・物性探索	「光科学の未来を拓く - Frontier and New Prospects in Optical Science -」 (ショート口頭講演)		「光科学の未来を拓く - Frontier and New Prospects in Optical Science -」 (ショート口頭講演)	7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント	
	ZJ 1F-6B-104	190	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	スピントロニクスデバイスの新展開	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術		
	ZK 1F-6B-103	190	12.9 有機トランジスタ	「印刷エレクトロニクスの現状と展望」	10.1 新物質創生・物性探索	「光学論文賞受賞記念講演」	12.8 有機 EL	12.8 有機 EL	12.8 有機 EL	12.8 有機 EL
	ZL 1F-6B-102	340	12.4 光機能材料・デバイス	プラズマエレクトロニクスと分子制御	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス	12.3 電子機能材料・デバイス
	ZM 1F-6B-101	340	11.1 基礎物性	超伝導分科会企画「超伝導で“進む”未来技術の最新動向~超伝導の物流・交通への展開~」	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ (ショート口頭講演)	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ
	ZN 1F-6C-104	170	12.5 液晶 (ショート口頭講演)	「半導体計測・評価技術 (3) - 最先端プロセスの要求に応える計測評価技術の進展」	「X線による埋もれた固液界面の精密科学の可能性」			APEX/JJAP フレンドシップミーティング		

# 日程表 (会場別) 2

東海大学

会場名	収容人数	3月17日 (水)		3月18日 (木)		3月19日 (金)		3月20日 (土)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
総合体育館	ZV 特設会場	200	第46回スクール 「コンピューター・シミュレーション・マテリアルズ・デザイン (CMD*) 入門」		第46回スクール 「集積化 MEMS 技術-基礎から応用」					
松前記念館	TA 講堂	490		講演奨励賞贈呈式 評議員会 業績賞・研究分野業績 賞授賞式	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶		応用物理学会/日本工 学アカデミー共同企画 「20年後を見据える 科学技術人材育成-グ ローバルに活躍する自 立型女性・若手研究者 /技術者」		
2号館	TB 1F-2N-101	1000	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	特別企画シンポジウム 「応用物理学の将来ビジョン-アカデミック ロードマップと発展史マップ」		15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶		
	TC 1F-2E-102	285	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶		17.3 新機能探索・基 礎物性評価	17.3 新機能探索・基 礎物性評価
	TD 1F-2E-101	285	「ナノカーボン材料の最新動向: グラフェン、 ナノチューブ、フラレン」		17.2 構造制御・プロ セス	17.2 構造制御・プロ セス	17.4 デバイス応用	17.3 新機能探索・基 礎物性評価	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用
	TE 1F-2W-101	285	14.5 半導体光物性・ 光デバイス		17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術 17.4 デバイス応用	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス
	TF 1F-2W-102	285	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	「多元系化合物のナノ 領域・界面キャラクタ リゼーション-CIGS の物性・デバイス評価 の基礎と応用」	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス
14号館	TG 1F-14-103	173	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	16.3 シリコン系太陽 電池	16.3 シリコン系太陽 電池	16.3 シリコン系太陽 電池	ランダム系フォトエレ クトロニクス研究会企 画「ナノ構造・粒子分 散系の光物性」	16.3 シリコン系太陽 電池	
	TJ 2F-14-201	192	15.6 IV 族系化合物 (ショート口頭講演)	15.5 IV 族結晶, IV- IV 族混晶	15.6 IV 族系化合物 (ショート口頭講演)	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	機能性酸化物研究グ ループ企画「機能性酸 化物における評価技 術: なにかどこまでわ かるのか?」	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料
	TK 2F-14-202	242			14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.5 半導体光物性・ 光デバイス	14.4 超高速・機能デ バイス	「2020~30年代の ナノエレクトロニクス デバイスの本命を考 える」	14.4 超高速・機能デ バイス	14.4 超高速・機能デ バイス
	TL 2F-14-203	242	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」	6.1 強誘電体薄膜	「強誘電体薄膜の最近 の進展」メモリからエ ネルギー、セキュア用 途へ!」		
	TM 2F-14-204	192	14.2 超薄膜・量子ナ ノ構造 (ショート口頭講演)		14.2 超薄膜・量子ナ ノ構造 (ショート口頭講演)	14.1 探索的材料物性	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」	合同セッションK「フ イドギャップ酸化物半 導体材料・デバイス」		
	TN 3F-14-302	105		「大型真空システムの 現状と今後の展開」	16.1 基礎物性・評価	16.2 プロセス技術・ デバイス	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性		
	TQ 3F-14-304	151	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス
	TR 3F-14-305	151	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	薄膜・表面物理分科会企画「ナノ材料・デバイ スのためのプローブ顕微鏡技術」		6.6 プローブ顕微鏡	
	TS 3F-14-306	105	6.6 プローブ顕微鏡	「ナノスケール分光法 による顕微評価・解析 技術の最前線」	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	14.3 プロセス技術・ 界面制御	14.3 プロセス技術・ 界面制御	15.7 エピタキシーの 基礎	
	TV 3F-14-307	105	15.1 ハルク結晶成長	15.1 ハルク結晶成長	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜
TW 3F-14-310	111	15.3 III-V 族エピタキ シャル結晶	15.3 III-V 族エピタキ シャル結晶	15.3 III-V 族エピタキ シャル結晶	15.3 III-V 族エピタキ シャル結晶	15.3 III-V 族エピタキ シャル結晶	15.2 II-VI 族結晶	15.8 結晶評価, ナノ 不純物・結晶欠陥	15.8 結晶評価, ナノ 不純物・結晶欠陥	
総合体育館	ポスターセッション	3.7 近接場光学 6.5 表面物理・真空	<前半> 5.3 光制御 14.2 超薄膜・量子ナ ノ構造 <後半> 12.5 液晶 12.6 高分子・ソフト マテリアル 15.6 IV 族系化合物	3.7 近接場光学 18.2 教育	<前半> 5.3 光制御 6.5 表面物理・真空 15.6 IV 族系化合物 <後半> 6.5 表面物理・真空 13.3 絶縁膜技術 14.2 超薄膜・量子ナ ノ構造	9.3 ナノエレクトロニ クス 13.3 絶縁膜技術	<前半> 2.1 計測・制御技術 7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 10.3 磁気記録媒体・磁 気センサー 13.3 絶縁膜技術 <後半> 8.5 プラズマナノテク ノロジー 8.6 プラズマ現象・新 応用・融合分野 12.9 有機トランジス タ	9.3 ナノエレクトロニ クス 11.5 接合, 回路作製 プロセスおよびデジ タル応用 13.3 絶縁膜技術		